



**SOITEC ET LA SOCIÉTÉ CHINOISE SILIAN SIGNENT UN ACCORD CONJOINT  
PORTANT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE PSEUDO-SUBSTRATS EN NITRURE DE  
GALLIUM DANS LE BUT DE PRODUIRE DES DIODES  
ÉLECTROLUMINESCENTES PLUS EFFICACES**

**L'utilisation de cette technologie d'épithaxie originale augmente la productivité de  
fabrication des diodes électroluminescentes et accélère l'adoption  
de solutions d'éclairage à LED**

*Bernin, France, et Chongqing, Chine, le 9 Juillet 2012* — Soitec (Euronext), leader mondial de la génération et de la production de matériaux semi-conducteurs d'extrêmes performances pour l'électronique et l'énergie, et la société chinoise Chongqing Silian Optoelectronics Science & Technology Co., Ltd. (Silian), fournisseur reconnu de matériaux, produits et systèmes destinés à l'industrie de l'éclairage, ont signé un accord de partenariat portant sur le développement conjoint de pseudo-substrats en nitrure de gallium (GaN) utilisant la HVPE ou méthode d'épithaxie en phase vapeur aux hydrures (Hydride Vapor Phase Epitaxy). Les pseudo-substrats de GaN ainsi obtenus permettent de fabriquer des diodes électroluminescentes (LED) performantes en réalisant des économies exceptionnelles.

L'accord de développement conjoint signé par les deux sociétés permettra de valider les concepts de fabrication et la commercialisation de ces pseudo-substrats en nitrure de gallium utilisant les substrats de saphir de Silian et la technologie HVPE de Soitec. Les deux partenaires envisagent d'échantillonner les premiers pseudo-substrats en GaN cette année.

Chantal Arena, Directrice générale de Soitec Phoenix Labs, où a été développé la technologie HVPE, a déclaré : « *Notre stratégie était d'utiliser les caractéristiques des équipements d'épithaxie utilisés couramment en production dans l'industrie des semi-conducteurs à partir de silicium et d'y ajouter notre système original d'injection de la source de gallium pour créer un équipement HVPE de haute productivité. Nous avons ensuite développé avec succès des procédés de croissance cristalline extrêmement rapide qui permettent de réaliser ces pseudo-substrats en nitrure de gallium de façon nettement moins onéreuse qu'avec la technique d'épithaxie en phase vapeur utilisant des organométalliques beaucoup plus couteux (MOVPE).* »

« *Silian se félicite de collaborer avec Soitec et d'adopter sa technologie HVPE* », a déclaré David Reid, Directeur général (COO) de Silian. « *Grâce à l'expansion de nos activités de fabrication de substrats en saphir en Chine, nous sommes bien positionnés pour saisir cette opportunité et proposer ces pseudo-substrats à moindre coût à nos clients de substrats en saphir.* »

« *Cette évolution de la technologie HVPE inaugure un modèle économique révolutionnaire grâce auquel les fabricants de diodes LED pourront libérer jusqu'à 60 % de leur capacité MOVPE. Les fabricants de diodes LED peuvent à présent se concentrer sur l'amélioration des couches les plus délicates, qui constituent la partie électroluminescente des diodes* », a déclaré André-Jacques Auberton-Hervé,

Président-Directeur général de Soitec. « *Outre cette opportunité commerciale, nous explorons la possibilité d'élargir notre coopération avec Silian dans le domaine de l'éclairage par LED, en utilisant l'expertise en croissance épitaxiale accumulée par Soitec Phoenix Labs, notre filiale basée en Arizona.* »

Xiaobo Xiang, Président de China Silian Instruments Group, maison-mère de Silian, a ajouté : « *Soitec et Silian disposent de technologies complémentaires très attractives. C'est pourquoi nous sommes impatients d'explorer avec Soitec les opportunités commerciales que peuvent offrir les vastes marchés des matériaux, des diodes LED et de l'éclairage à nos deux entreprises.* »

### ***A propos de Silian***

Chongqing Silian Optoélectronique Science & Technology Co., Ltd (Silian) a été fondée par l'entreprise Chinoise Silian Instrument Group Co., Ltd pour le développement de l'industrie LED. Suite à l'acquisition de l'entreprise Honeywell dédiée aux substrats de saphir, Silian est devenue la première entreprise Chinoise à pouvoir produire des substrats de saphir de large diamètre et de haute qualité et ayant des capacités de R & D. La gamme de produits Silian couvre une gamme complète de la chaîne d'approvisionnement LED, leader mondial de substrats de large diamètre de substrats de saphir, de composants LED, écrans LED, éclairage LED et une technologie intelligente de contrôle de système d'éclairage. Basé sur les technologies de base de substrats de saphir, l'éclairage LED et une méthode de fabrication flexible, Silian est la plus grande entreprise industrielle de semi-conducteurs économes en énergie dans l'ouest de la Chine. Silian a un fort réseau de ventes et de distribution, des usines sous traitance de fabrication et des centres de R & D situés en Chine et en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez le site: [www.silianopto.com](http://www.silianopto.com)

### ***A propos de Soitec***

Soitec (Euronext Paris) est une entreprise industrielle internationale dont le cœur de métier est la génération et la production de matériaux semi-conducteurs d'extrêmes performances. Ses produits, des substrats pour circuits intégrés (notamment à base de SOI - Silicium On Insulator) et des systèmes photovoltaïques à concentration (CPV), ses technologies Smart Cut™, Smart Stacking™ et Concentrix™ ainsi que son expertise en épitaxie en font un leader mondial. Soitec relève les défis de performance et d'efficacité énergétique pour une large palette d'applications destinées aux marchés de l'informatique, des télécommunications, de l'électronique automobile, de l'éclairage et des centrales solaires à forte capacité. Soitec a aujourd'hui des implantations industrielles et des centres de R&D en France, à Singapour, en Allemagne et aux Etats-Unis. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet [www.soitec.com](http://www.soitec.com).

#### **Contact Presse internationale**

Camille Darnaud-Dufour  
+33 (0)6 79 49 51 43  
(any time zone)  
[camille.darnaud-dufour@soitec.com](mailto:camille.darnaud-dufour@soitec.com)

#### **Relations Investisseurs**

Olivier Brice  
+33 (0)4 76 92 93 80  
[olivier.brice@soitec.com](mailto:olivier.brice@soitec.com)

#### **Contact Presse française**

Marie-Caroline Saro  
H&B Communication  
+33 (0)1 58 18 32 44  
[mc.saro@hbcommunication.fr](mailto:mc.saro@hbcommunication.fr)

###